دراسة تاثير التشعيع بالليزر في بعض الخواص البصرية لغشاء CdTe الرقيق عبد المجيد عيادة السامرائي و محمد شياع مرعي و عدنان رعد احمد تقسم الفيزياء ، كلية العلوم ، جامعة تكريت ، تكريت ، العراق

(تاريخ الاستلام: ٢٩ / ١٠ /٢٠٠٧ ، تاريخ القبول: ٢٦ / ٢ / ٢٠٠٨)

الملخص

تم في هذا البحث دراسة بعض الخصائص البصرية لغشاء CdTe بعد التشعيع بليزر ايون الاركون المستمر ولمدة ١٥ دقيقة، اذ تم دراسة كل من فجوة الطاقة البصرية الممنوعه للانتقال المباشر المسموح ، معامل الامتصاص وكذلك معامل الخمود كدالة لطاقة الفوتون .تبين من الدراسة ان فجوة الطاقة تقلصت نتيجة التشعيع باشعة الليزر، اما معامل الامتصاص والخمود فقد ازدادت بعد التشعيع. اذ نلاحظ بان فجوة الطاقة 201 واصبحت بعد التشعيع 1.1eV

المقدمة:

لقد لعبت تقنية الاغشية الرقيقة دورا هاما جاد في الصناعة وقد بدأ تطور تقنية الاغشية الرقيقة بالازدياد عندما اصبح العالم بحاجة ملحة الى صناعة الدوائر المتكاملة، ان من اهم ما يميز الاغشية الرقيقة هي قلة كلفتها وصغر حجمها اذا ما قورت بالمادة بحالتها الحجمية [1,2].

تستند الاغشية الرقيقة على ثلاث قواعد اساسية وهي: التصنيع والخواص واخيرا النطبيق. ان من اهم تطبيقات الاغشية الرقيقة هي الالكترونيات الدقيقة، الخلايا الشمسية وكذلك الطلاء بالنسبة للمعادن [3,4].

تعد اغشية CdTe من الاغشية ذات التطبيقات الكثيرة ومنها صناعة الخلايا الشمسية ويمكن تحضير اغشية رقيقة من مركب CdTe باكثر من طريقة منها طريقة الرش الكيميائي الحراري وطريقة التبخير الحراري الفراغي وايضا طريقة الترذيذ[5,6,7].

الجانب العملي والنظري:

تم تحضير غشاء CdTe وذلك باستخدام منظومة التبخير الحراري الفراغي نوعBalazer تحت ضغط 10⁻⁶Torr وباستخدام ارضيات من الزجاج الاعتيادي، وقد تم استخدام الطريقة الوزنية لقياس سمك الاغشية التي تم تحضيرها وهذه الطريقة تعتمد على فرق الوزن قبل الترسيب وبعد الترسيب، باستخدام ميزان حساس تصل حساسيته الى 10⁻⁴gm وبعد ان تم تحضير العينة تم تشعيعها بليزر ايون الاركون المستمر ولمدة15min. وبعد ذلك تم التعرف على طيفي الامتصاصية والنفاذية قبل التشعيع وبعده باستخدام جهاز مطياف من نوع(UV-Visible spectrophotometer) ومن طيفى الامتصاصية والنفاذية تم

حساب بعض الثوابت البصرية [12].

النتائج والمناقشة:

فجوة الطاقة البصرية الممنوعة:

 $\alpha hv = A(hv - E_g)^r \dots (1)$ كدالة الطاقة الفوتون قبل التشعيع والذي ويبيين الشكل(1) تغير $^2(\alpha hv)$ كدالة لطاقة الفوتون قبل التشعيع والذي من خلاله نستطيع حساب قيمة فجوة الطاقة البصرية الممنوعة للانتقال المباشر المسموح، اذ نلاحظ من الشكل بان فجوة الطاقة مساوية الى (1.2)eV ما الشكل (1) فيمثل تغير $^2(vhv)$ كدالة لطاقة الفوتون بعد التشعيع بليزر ايون الاركون المستمر ولمدة ١٥ دقيقة اذ نلاحظ بان قيمة فجوة الطاقة البصرية الممنوعة للانتقال المباشر المسموح قد اصبحت التشعيع بليزر ايون الاركون المستمر ولمدة ١٥ دقيقة اذ نلاحظ بان قيمة فجوة الطاقة البصرية الممنوعة للانتقال المباشر المسموح قد اصبحت الالكترونات داخل المادة، أي يؤثر على طريقة ترتيب الذرات داخل الشبيكة البلورية، اذ من الممكن ان يؤدي التشعيع الى تغير المركب من الحالة البلورية، اذ من الممكن ان يؤدي التشعيع الى تغير المركب من الحالة البلورية الى الحالة العشوائية وبالتالي فان الكثير من مستويات الطاقة الموضعية الخالية من الالكترونات سوف تظهر وتكون اما قريبة من حزمة التكافؤ او حزمة التوصيل، اذ من الممكن ان تستقر فيها الالكترونات لفترات زمنية قصيرة جدا قبل انتقالها الى حزمة التوصيل للمساهمة في عملية التوصيل الكهربائي.





شكل (1) فجوة الطاقة البصرية الممنوعة قبل التشعيع



شكل (٢) فجوة الطاقة البصرية الممنوعة بعد التشعيع

معامل الامتصاص:

تم دراسة معامل الامتصاص قبل وبعد التشعيع بليزر ايون الاركون وذلك من المعادلة (2)....... $A = 2.303 \frac{A}{t}$ ، اذ نلاحظ من الشكل (٣) والذي يمثل تغير معامل الامتصاص كدالة لطاقة الفوتون قبل التشعيع اذ نلاحظ بان معامل الامتصاص يمتلك قيما عالية اكبر من ¹⁻cm(10⁵) وهذا ريما يدل على حدوث انتقالات الكترونية مباشرة وقد تم التحقق من ذلك عند حسابنا لقيمة فجوة الطاقة البصرية الممنوعة. اما بالنسبة لتاثير التشعيع فنلاحظه من خلال الشكل (٤) والذي يمثل تغير معامل الامتصاص كدالة لطاقة الفوتون بعد التشعيع بليزر ايون الاركون ولمدة ربع ساعة اذ نلاحظ زيادة في قيمة معامل الامتصاص عن قيمته قبل التشعيع ويمكن ان يعزى ذلك الى زيادة الامتصاصية بزيادة طاقة الفوتونات الساقطة وبالتالي يؤدي

ذلك الى زيادة واضحة في قيمة معامل الامتصاص وإيضا بسبب نقصان في قيمة فجوة الطاقة البصرية الممنوعة وبالتالي فان فوتونات بطاقة اقل يمكن ان تمتص من قبل الكترونات ذرات مادة الغشاء الرقيق وتنتقل من حزمة التكافؤ الى حزمة التوصيل بصورة مباشرة وبالتالي تساهم في زيادة قيمة معامل الامتصاص البصري اذ نلاحظ من الشكل نفسه بان قيم معامل الامتصاص تبدا بالطاقات الفوتونية الاقل من من طاقة الفجوة ويزداد الامتصاص تدريجيا بعد ذلك، اذ يكون هناك زيادة واضحة في قيمة معامل الامتصاص عندما تكون طاقة الفوتونات الساقطة مساوية او اكبر من طاقة الفجوة البصرية الممنوعة وهذه الزيادة تستمر الى حد معين وبعدها تبدا بالهبوط.



شكل (٣) معامل الامتصاص قبل التشعيع بليزر ايون الاركون كدالة طاقة الفوتون



شكل (٤) معامل الامتصاص بعد التشعيع بليزر ايون الاركون كدالة لطاقة الفوتون

معامل الخمود:

تم حساب معامل الخمود من المعادلة (3)........ $K = \frac{\alpha\lambda}{4\pi}$ ،اذ يمثل الشكل (٥) تغير معامل الخمود كدالة لطاقة الفوتون قبل التشعيع بليزر ايون الاركون المستمر اذ نلاحظ بان معامل الخمود يسلك نفس السلوك الذي يسلكه معامل الامتصاص وذلك لارتباطهما بالعلاقة المذكورة بالمعادلة رقم (٢). اذ نلاحظ بان اعلى قيمة لمعامل الخمود قبل التشعيع بليزر ايون الاركون هي تقريبا (١,٤٥) عند الطاقات الفوتونية الاكبر بقليل من قيمة فجوة الطاقة الامر) معامل من قبما من معامل من معامل الخمود من المذي يمثل

الخمود كدالة لطاقة الفوتون بعد التشعيع بليزر ايون الاركون ولمدة (١٥) دقيقة، اذ نلاحظ زيادة واضحة في قيمة معامل الخمود ويمكن ان يعزى ذلك الى زيادة معامل الامتصاص بعد التشعيع بسبب ارتباطهما بعلاقة طردية كما ذكرنا سابقا ونلاحظ بعد ذلك حصول هبوط في قيم معامل الخمود عندما تكون طاقة الفوتونات الساقطة اكبر كثيرا من طاقة الفجوة الممنوعة.



شكل (٦) معامل الخمود بعد التشعيع بليزر ايون الاركون المستمر كدالة لطاقة الفوتون

الاستنتاجات:

في ضوء نتائج البحث الحالي تبين ان التشعيع بواسطة ليزر الاركون على غشاء CdTe الرقيق ادى الى نقصان في قيمة فجوة الطاقة البصرية وزيادة في قيم كل من معامل الامتصاص البصري ومعامل الخمود.

المصادر

8. T. Sugimoto, G. E. Dirige, and A. Muramatsu, J. Colloid and Interface Sci. 182, 444 (1996).

9. T. L. Chu, and S. S. Chu, Solid-State Electronics 38, 533 (1995).

10. L. S. Birks, and H. Friedman, J. Appl. Phys. 16, 687 (1946).

11. K. L. Chopra, S. Major, and D. K. Pandya, Thin Solid Films 102, 1 (1983).

12. S. J. Lade, and C. D. Lokhande, Mat. Chem. Phys. 49, 160 (1997).

 M. A. Green, Prog. Photovoltaics 9, 123 (2001).
A. E. Rakhshani, and A. S. Al-Azab, J. Phys.: Condens. Matter 12, 8745 (2006).

- 3. G. Contreras .,O.S. Khomchenko Thin Solid Films 361, 378 (2004).
- 4. R. Padmavathy., Mat. Lett. 53, 321 (2005).
- 5. T. Sugimoto, G. E. Dirige, and A. Muramatsu, J. Colloid and Interface Sci. 182, 444 (2005).
- 6. J. M. Dona and J. Herero, J. Electrochem. Soc. 144, 4091 ($\gamma \cdot \cdot i$).

7. Britt, and C. Ferekides, Appl. Phys. Lett. 62, 2851 $({}^{\tau} \cdot \cdot {}^{\tau})$.

A Study of the effect of irradiation by laser on some optical properties of CdTe thin films.

Abdul –majeed E. Ibrahim¹, Mohammed Sh. Marie², Adnan R.Ahmed

¹Dept. of physics, college of education, University of tikrit, Tikrit, Iraq

² Dept. of physics, college of science, University of tikrit, , Tikrit, Iraq

(Received 29 / 10 / 2007, Accepted 26 / 2 / 2008)

Abstract:

in this research we studied some of the optical properties for CdTe thin film before and after irradiation by ion argon laser for 15 minutes, we calculated forbidden optical energy gap for allowed direct transition, absorption and extinction coefficient as a function to photon energy. We noted that the energy gap decreased because of the irradiation by laser, while absorption and extinction coefficients increased after irradiation. So we note that the energy gap is 1.2 eV, and after radiation it became 1.1 eV.